

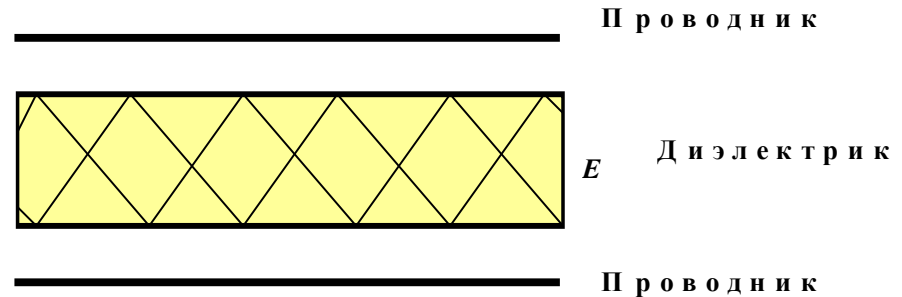
Энергия электрического поля.
Емкость.

- ▶ **Електроємкость проводника**

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

- ▶ **Електроємкость проводника** – это физическая величина, численно равная заряду, который необходимо сообщить проводнику, чтобы увеличить его потенциал на 1В.
- ▶ В СИ C измеряется в фарадах [1Ф = 1Кл / 1В].
- ▶ **Конденсатор** – система из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика, продольные размеры которых много больше расстояния между ними.

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$$



$\varphi_1 - \varphi_2$ – разность потенциалов между обкладками;

q – заряд конденсатора.

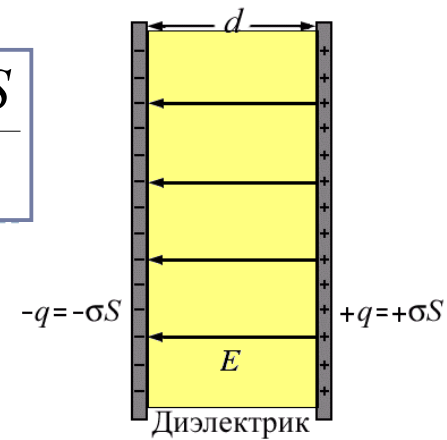


▶ Плоский конденсатор

Расстояние между обкладками d много меньше линейных размеров конденсатора.

Следовательно, поле конденсатора можно рассматривать как поле между двумя бесконечными пластинами.

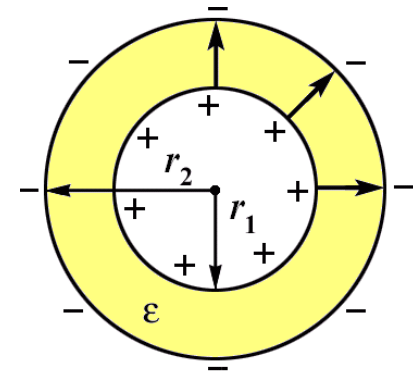
$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$



▶ Сферический конденсатор

Состоит из двух concentric обкладок сферической формы, разделенных слоем диэлектрика.

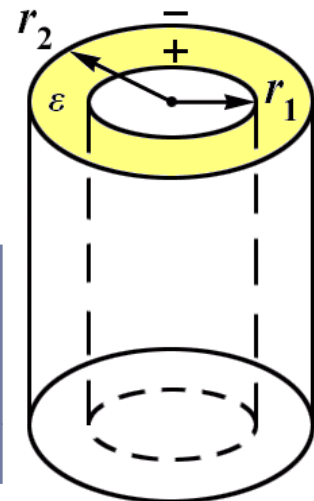
$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = 4\pi\varepsilon\varepsilon_0 \frac{r_1 \cdot r_2}{r_2 - r_1}$$



▶ Цилиндрический конденсатор

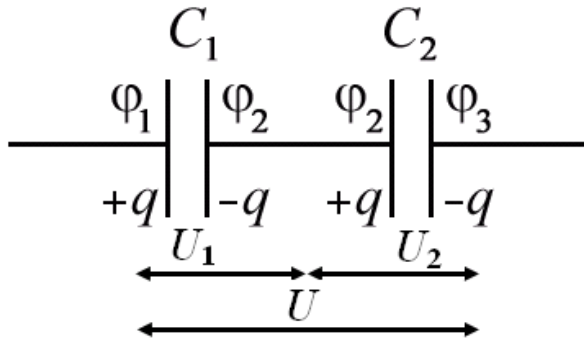
Состоит из двух полых коаксиальных цилиндров с радиусами r_1 и r_2 , вставленных один в другой ($r_1 < r_2$) и разделенных слоем диэлектрика.

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 l}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$



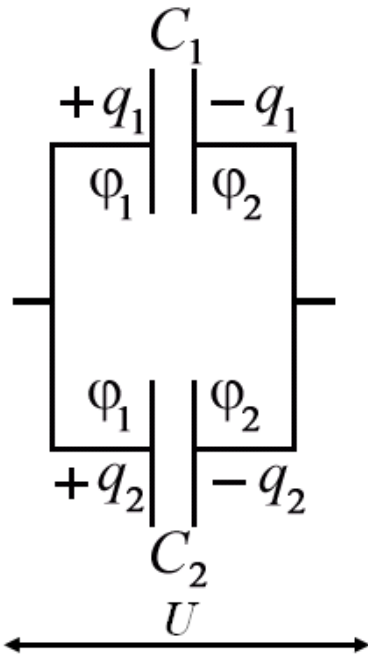
▶ **Соединения конденсаторов**

▶ Последовательное соединение конденсаторов



$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

▶ Параллельное соединение конденсаторов



$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$

Энергия заряженного проводника:

Энергия заряженного проводника равна работе, которую необходимо совершить, чтобы зарядить этот проводник:

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\phi^2}{2}$$

Энергия заряженного конденсатора

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2}$$

Объемная плотность энергии электрического поля

- энергия, приходящаяся на единичный объем однородного поля.

$$\omega = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{ED}{2}$$



Задача 1. Вычислить энергию поля заряженного проводящего шара радиуса R , помещенного в однородный безграничный диэлектрик.

▶ Решение:

Напряженность поля:
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Разобьем окружающее шар пространство на концентрические шаровые слои толщиной dr . Объем слоя: $V = 4\pi r^2 dr$

В нем заключена энергия $dW = \omega dV$.
$$\omega = \frac{\epsilon\epsilon_0}{2} E^2$$

$$dW = \frac{\epsilon\epsilon_0}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} dr$$

Тогда энергия поля

$$W = \int dW = \frac{q^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0 R}$$

$$W = \frac{q^2}{2C} \Rightarrow \text{для шара} \quad C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$$



Задача 2. В вершинах квадрата со стороной a находятся одинаковые по абсолютной величине заряды q . Определить энергию взаимодействия системы.

► Решение:

Взаимная потенциальная энергия двух зарядов:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

Если зарядов N штук, то энергия равна сумме энергий взаимодействия зарядов, взятых попарно:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i \neq k} W_{ik}, i \neq k$$

$$W_{ik} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_k}{r_{ik}}$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_k}{r_{ik}}$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$$

1-ый способ:

Пусть в вершинах квадрата находятся все положительные заряды. Каждый заряд взаимодействует попарно с другими. Тогда энергия всей системы:

$$W = W_{12} + W_{13} + W_{14} + W_{23} + W_{24} + W_{34}$$

Энергия взаимодействия двух точечных зарядов:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

$$W_{12} = W_{14} = W_{23} = W_{34} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{a}$$

$$W_{13} = W_{24} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{\sqrt{2}a}$$

$$\Rightarrow W = 4W_{12} + 2W_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{a} (4 + \sqrt{2})$$

Задача 2. В вершинах квадрата со стороной a находятся одинаковые по абсолютной величине заряды q . Определить энергию взаимодействия системы.

▶ Решение:

2-ой способ:

Пусть в вершинах квадрата на диагонали находятся отрицательные заряды.

Тогда энергия всей системы: $W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i$

φ_i – потенциал в точке, где находится i -ый заряд, создаваемый всеми другими зарядами (кроме i -го).

$$W = \frac{1}{2} (q_1 \varphi(1) - q_2 \varphi(2) + q_3 \varphi(3) - q_4 \varphi(4))$$

Определим потенциал по принципу суперпозиции:

$$\varphi(1) = -k \frac{q_2}{a} + k \frac{q_3}{\sqrt{2}a} - k \frac{q_4}{a} = -2k \frac{q}{a} + k \frac{q}{\sqrt{2}a} \quad \Rightarrow \varphi(1) = -\varphi(2) \\ = \varphi(3) = -\varphi(4)$$

$$\varphi(2) = k \frac{q_1}{a} + k \frac{q_3}{a} - k \frac{q_4}{\sqrt{2}a} = 2k \frac{q}{a} - k \frac{q}{\sqrt{2}a}$$

$$\varphi(3) = -k \frac{q_2}{a} + k \frac{q_3}{\sqrt{2}a} - k \frac{q_4}{a} = -2k \frac{q}{a} + k \frac{q}{\sqrt{2}a}$$

$$\varphi(4) = k \frac{q_1}{a} - k \frac{q_2}{\sqrt{2}a} + k \frac{q_3}{a} = 2k \frac{q}{a} - k \frac{q}{\sqrt{2}a}$$

$$W = 2q\varphi(1) \\ = 2q \left(-2k \frac{q}{a} + k \frac{q}{\sqrt{2}a} \right) \\ = k \frac{q^2}{a} (\sqrt{2} - 4)$$

▶ Энергия будет отрицательной, т.е. это энергия связи зарядов.

Задача 3. Уединенная металлическая сфера электроемкостью $C=10$ пФ заряжена до потенциала $\varphi=3$ кВ. Определить энергию W поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в три раза больше радиуса сферы.

► Решение:

Электроемкость сферы: $C = 4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R$

Т.к. сфера полая, то $\varepsilon=1$. $\Rightarrow R = \frac{C}{4\pi\varepsilon_0}$

Напряженность поля заряженной сферы: $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

Плотность энергии: $\omega = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$

$W = \int \omega dV$ $dV = 4\pi r^2 dr$

$$\begin{aligned} W &= \int \omega dV = \int_R^{3R} \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} dV = \int_R^{3R} \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} 4\pi r^2 dr = \int_R^{3R} \frac{4\pi\varepsilon_0 q^2 r^2 dr}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 r^4} = \int_R^{3R} \frac{q^2 dr}{8\pi\varepsilon_0 r^2} \\ &= \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{3R} \right) = \frac{q^2}{12\pi\varepsilon_0 R} = \frac{q^2}{3C} \end{aligned}$$

$$C = \frac{q}{\varphi} \Rightarrow q = C\varphi$$

$$W = \frac{C\varphi^2}{3}$$

$$W = 30 \text{ мкДж}$$

Задача 4. Найти объемную плотность энергии ω_0 электрического поля в точке, находящейся: а) на расстоянии $x = 2$ см от поверхности заряженного шара радиусом $R = 1$ см, б) вблизи бесконечно протяженной заряженной плоскости, в) на расстоянии $x = 2$ см от бесконечно длинной заряженной нити.

Поверхностная плотность заряда на шаре и плоскости $\sigma = 16,7$ мкКл/м², линейная плотность заряда на нити $\tau = 167$ нКл/м. Диэлектрическая проницаемость среды $\varepsilon = 2$.

► Решение:

а) Объемная плотность энергии для шара: $\omega_0 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}$

Напряженность поля, создаваемого заряженным шаром в точке r : $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}$

В точке x : $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 (R+x)^2}$

$$q = \sigma S = 4\pi R^2 \sigma$$

$$\omega_0 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{2} \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 (R+x)^2} \right)^2$$

$$\omega_0 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{2} \left(\frac{4\pi R^2 \sigma}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 (R+x)^2} \right)^2 = \frac{\sigma^2 R^4}{2\varepsilon\varepsilon_0 (R+x)^4}$$

$$\omega_0 = 0.097 \text{ Дж/м}^3$$



Задача 4. Найти объемную плотность энергии ω_0 электрического поля в точке, находящейся: а) на расстоянии $x = 2$ см от поверхности заряженного шара радиусом $R = 1$ см, б) вблизи бесконечно протяженной заряженной плоскости, в) на расстоянии $x = 2$ см от бесконечно длинной заряженной нити.

Поверхностная плотность заряда на шаре и плоскости $\sigma = 16,7$ мкКл/м², линейная плотность заряда на нити $\tau = 167$ нКл/м. Диэлектрическая проницаемость среды $\varepsilon = 2$.

► Решение:

б) Объемная плотность энергии для плоскости:
$$\omega_0 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}$$

Напряженность поля, создаваемого заряженной плоскостью:
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}$$

$$\omega_0 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{2} \left(\frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0} \right)^2 = \frac{\sigma^2}{8\varepsilon\varepsilon_0} \quad \omega_0 = 1.97 \text{ Дж/м}^3$$

в) Объемная плотность энергии для нити:
$$\omega_0 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}$$

Напряженность поля, создаваемого заряженной нитью на расстоянии x :

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x} \quad \omega_0 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{2} \left(\frac{\tau}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 x} \right)^2 = \frac{\tau^2}{8\pi^2\varepsilon\varepsilon_0 x^2}$$

$$\omega_0 = 4.99 \cdot 10^{-2} \text{ Дж/м}^3$$



Задача 5. Плоский воздушный конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом $r=10$ см каждая. Расстояние d_1 между пластинами равно 1 см. Конденсатор зарядили до разности потенциалов $U=1,2$ кВ и отключили от источника тока. Какую работу A нужно совершить, чтобы, удаляя пластины друг от друга, увеличить расстояние между ними до $d_2=3,5$ см.

► Решение:

$$A = W_2 - W_1 \qquad W = \frac{q^2}{2C}$$

$$A = \frac{q^2}{2C_2} - \frac{q^2}{2C_1} = \frac{q^2}{2} \left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_1} \right)$$

Заряд не меняется, $q = C_1 U$ $C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_1}$ $C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_2}$ $S = \pi r^2$

$$A = \frac{C_1^2 U^2}{2} \left(\frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_1} \right) = \frac{\varepsilon_0^2 S^2 U^2}{2d_1^2} \left(\frac{d_2}{\varepsilon_0 S} - \frac{d_1}{\varepsilon_0 S} \right) = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d_1^2} (d_2 - d_1) = \frac{\pi r^2 \varepsilon_0 U^2}{2d_1^2} (d_2 - d_1)$$

$$A = 50 \text{ мкДж}$$

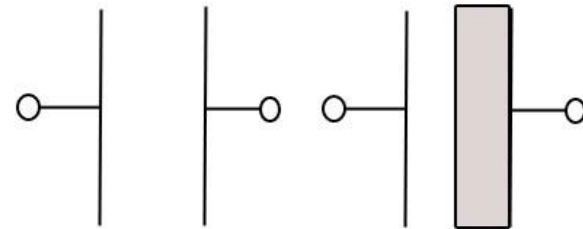


Задача 6. Как изменится ёмкость плоского воздушного конденсатора, если между его обкладками поместить стеклянную пластину ($\varepsilon = 6$), толщина которой равна половине расстояния между обкладками?

► Решение:

C_0 – ёмкость конденсатора до введения стеклянной пластины.

C – ёмкость конденсатора после введения стеклянной пластины.



После введения стеклянной пластины конденсатор можно рассматривать как два последовательно соединенных конденсатора.

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad C_1 = \frac{2\varepsilon_0 S}{d}, C_2 = \frac{2\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$$

C_1 – воздушный конденсатор толщиной $d/2$, C_2 – конденсатор со стеклянной пластиной толщиной $d/2$.

$$C = \frac{2\varepsilon\varepsilon_0 S}{d(1 + \varepsilon)} = \frac{2\varepsilon C_0}{d(1 + \varepsilon)} \quad C = 1.7C_0$$



Задача 7. Площадь каждой обкладки плоского конденсатора $S=1 \text{ м}^2$, расстояние между обкладками $d=5 \text{ мм}$. Зазор между обкладками заполнен диэлектриком, проницаемость которого изменяется в направлении, перпендикулярном к обкладкам, по линейному закону от значения $\varepsilon_1=2$ вблизи одной обкладки до $\varepsilon_2=5,44$ вблизи другой. Определить емкость C конденсатора.

▶ Решение:

Для нахождения емкости конденсатора разобьём диэлектрик на слои толщиной dx . Получим систему последовательно соединенных конденсаторов. Тогда емкость такой системы:

$$\varepsilon(x) = kx + b$$

$$b = \varepsilon_1$$

$$k = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} = \int_0^d \frac{1}{C_i} \quad C_i = \frac{\varepsilon(x)\varepsilon_0 S}{dx}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{\varepsilon_0 S} \int_0^d \frac{dx}{kx + b} = \frac{1}{\varepsilon_0 S k} \ln(kx + b) \Big|_0^d = \frac{1}{\varepsilon_0 S k} \ln\left(\frac{kd + b}{b}\right) = \frac{d}{\varepsilon_0 S} \frac{\ln(\varepsilon_2/\varepsilon_1)}{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 S (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln(\varepsilon_2/\varepsilon_1)}$$

$$C = 6.1 \text{ нФ}$$



Задача 8. Конденсатор ёмкостью 3 мкФ заряжен до разности потенциалов 300 В, конденсатор ёмкостью 2 мкФ – до 200 В. Оба конденсатора соединены после зарядки параллельно одноименными полюсами. Какая разность потенциалов установится на обкладках конденсаторов после их соединения?

► Решение:

$$C = \frac{q}{U} = \frac{(q_1 + q_2)}{U}$$

С другой стороны $C = C_1 + C_2$.

$$\Rightarrow C_1 + C_2 = \frac{(q_1 + q_2)}{U} \qquad U = \frac{(q_1 + q_2)}{(C_1 + C_2)}$$

$$C_1 = \frac{q_1}{U_1} \qquad q_1 = C_1 U_1$$

$$\Rightarrow U = \frac{(C_1 U_1 + C_2 U_2)}{(C_1 + C_2)}$$

$$C_2 = \frac{q_2}{U_2} \qquad q_2 = C_2 U_2$$

$$U = 260 \text{ В}$$



Задача 9. Два конденсатора емкостями $C_1=3$ мкФ и $C_2=6$ мкФ соединены между собой и присоединены к батарее с ЭДС 120 В. Определить заряды Q_1 и Q_2 конденсаторов и разности потенциалов U_1 и U_2 между их обкладками, если конденсаторы соединены: 1) параллельно; 2) последовательно.

► Решение:

1) При параллельном соединении: $U_1 = U_2 = \varepsilon = 120$ В

$$Q_1 = C_1 U_1 = 0.72 \text{ мКл}$$

2) При последовательном соединении: $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 2$ мкФ

$$Q_1 = Q_2 = Q = C \varepsilon = 0.24 \text{ мКл}$$

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = 80 \text{ В}$$

$$U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = 40 \text{ В}$$



Задача 10. Конденсаторы емкостями $C_1=2$ мкФ, $C_2=2$ мкФ, $C_3=3$ мкФ, $C_4=1$ мкФ соединены так, как указано на рисунке. Разность потенциалов на обкладках четвертого конденсатора $U_4=100$ В. Найти заряды и разности потенциалов на обкладках каждого конденсатора, а также общий заряд и разность потенциалов батареи конденсаторов.

► Решение:

$$Q_4 = C_4 U_4 = 10^{-4} \text{ Кл}$$

$$Q_2 = Q_3 = C_2 U_2 = C_3 U_3 \quad U_3 = \frac{C_2 U_2}{C_3}$$

$$U_4 = U_2 + U_3 \Rightarrow U_4 = U_2 \left(1 + \frac{C_2}{C_3} \right) \Rightarrow U_2 = \frac{U_4}{\left(1 + \frac{C_2}{C_3} \right)} = 60 \text{ В}$$

$$U_3 = U_4 - U_2 = 40 \text{ В}$$

$$Q_2 = Q_3 = C_2 U_2 = C_3 U_3 = 1.2 \cdot 10^{-4} \text{ Кл}$$

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = 110 \text{ В}$$

$$Q_1 = Q_2 + Q_4 = 2.2 \cdot 10^{-4} \text{ Кл}$$

$$U = U_1 + U_4 = 210 \text{ В}$$

$$Q = Q_1 = 2.2 \cdot 10^{-4} \text{ Кл}$$

